

高周波スパッタリング装置

目的 高周波スパッタリングにより、相変化材料、金属、絶縁体、磁性体などの薄膜を形成する。

仕様 (株)アルバック製 MNS-3000-RF
試料サイズ:3 インチ(膜厚均一化のための自転機構付き)
ターゲットサイズ:2 インチ(専用ターゲットホルダーにボンディング)
マグネトロンカソード:2 インチ×3 台
準備室:試料交換用の導入室付きで、逆スパッタ機構も搭載。
高周波電源:1 台(カソード 3 台および逆スパッタ機構で切り替えて使用)
ガス導入系:マスフローコントローラー2 系統(Ar, 高純度 N₂)、手動リーク用 1 系統(N₂)

利用手順

利用希望者は、事前に装置管理者に電話で申請すること。申請内容は、利用希望日時、所属研究室、氏名。利用後は、備え付けの使用記録簿に所定の事項を記入すること。

利用上の注意

所定の講習を受け、装置動作原理を理解し、装置の取り扱いに習熟した者のみに本装置の利用を認める。装置の異常が発生した場合には速やかに装置管理者に連絡すること。試料交換、ターゲット交換等で成膜室および準備室内部に触れる場合には、必ず清浄な手袋を着用のこと。

設置場所 クリーンルーム 1

装置責任者 電子情報部門 尹友(TEL:1724)

連絡先(装置管理者) 電子情報部門 尹友(TEL:1724, email: yinyou@gunma-u.ac.jp)

